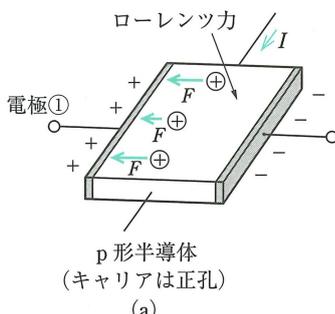
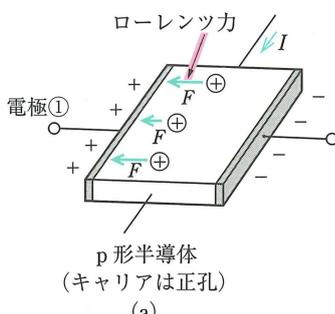
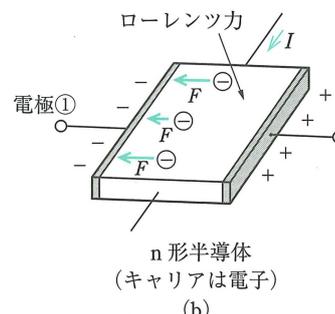
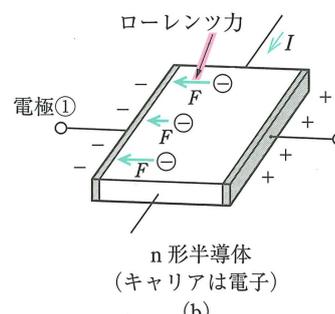
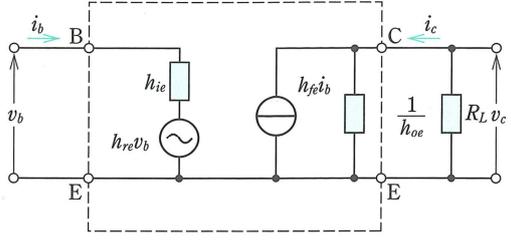
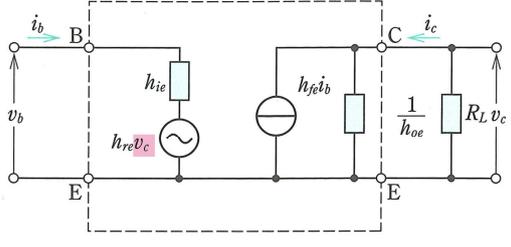


《正誤表》

書名 : 電験三種 理論 考え方解き方 (電験三種考え方解き方研究会編)

版数 : 第1版1刷 (2010年11月30日)

頁	場所	誤	正
3	(右段) 下から1行目	$= \frac{1}{2} \mu H \text{ [J/m}^3\text{]}$	$= \frac{1}{2} \mu H^2 \text{ [J/m}^3\text{]}$
89	下から9行目	$E = I(r+R) = 5(r+10)$	$V = I(r+R) = 5(r+10)$
	下から7行目	$E = I(r+R) = 6(r+8)$	$V = I(r+R) = 6(r+8)$
	下から1行目	$E = 5(r+10) = 5(2+10) = 60 \text{ [V]}$	$V = 5(r+10) = 5(2+10) = 60 \text{ [V]}$
102	例題3 左側の図		
144	下から5行目	$E = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} = \sqrt{12^2 + (2 \times 8)^2} = 20 \text{ [V]}$	$E = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} = \sqrt{(2 \times 8)^2 + 12^2} = 20 \text{ [V]}$
155	下から3行目	$R_2 + R_3 = 2R_3 + \frac{2R_1 + R_2}{R_1 + R_2}$	$R_2 + R_3 = 2R_3 + \frac{2R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
166	下から6行目	$I_C = \frac{V}{X_L}$	$I_L = \frac{V}{X_L}$
192	図 5.10	<p style="text-align: center;">図 5.10 n形半導体</p>	<p style="text-align: center;">図 5.10 n形半導体</p>

頁	場所	誤	正
201	図 5.18	<p>【誤】</p>  <p>p 形半導体 (キャリアは正孔) (a)</p> <p>【正】</p>  <p>p 形半導体 (キャリアは正孔) (a)</p>	<p>【誤】</p>  <p>n 形半導体 (キャリアは電子) (b)</p> <p>【正】</p>  <p>n 形半導体 (キャリアは電子) (b)</p>
208	図 5.21	<p>【誤】</p>  <p>図 5.21</p> <p>【正】</p>  <p>図 5.21</p>	
220	下から 3 行目	$V_{i2} + R_{i1} i = 0$	$V_{i2} + R_{i1} i = 0$
259	上から 3 行目	~略~ 電流磁束による過電流と電圧磁束 ~略~	~略~ 電流磁束による渦電流と電圧磁束 ~略~